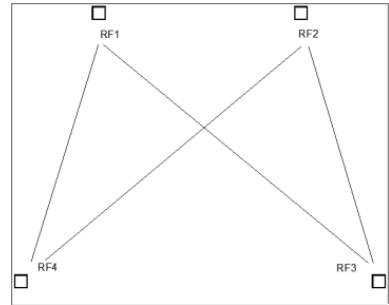


性能特点：

- 频带：2~18GHz
- 插入损耗：6.0dB
- 隔离度：45dB
- 输入 P1dB：18dBm
- V1、V2、V3、V4 在 0/-5V 不同供电切换开关通路
- 芯片尺寸：3.1mm×2.5mm×0.1mm


产品简介：

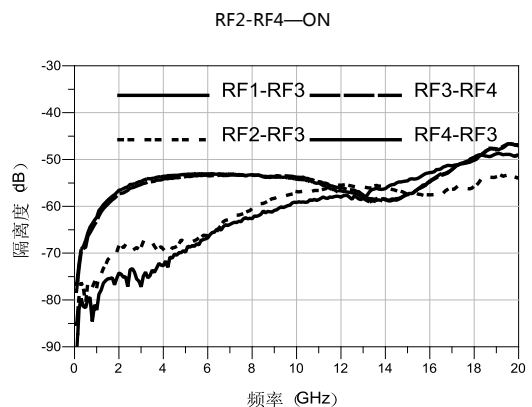
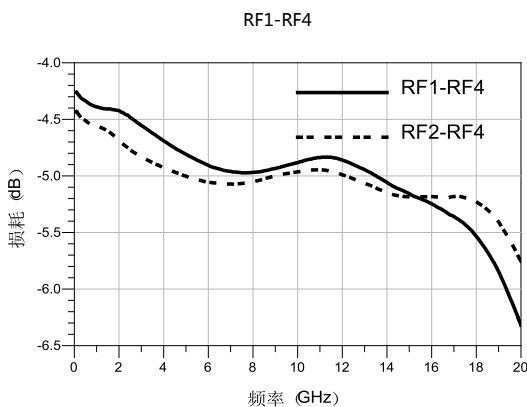
HH-SW0218A4 是一款 GaAs MMIC 单刀双掷匹配式开关芯片，其频率范围覆盖 2~18GHz，整个带内插入损耗小于 6.0dB。V1、V2、V3、V4 在 0/-5V 不同供电切换开关通路。

电参数：(TA=25°C)

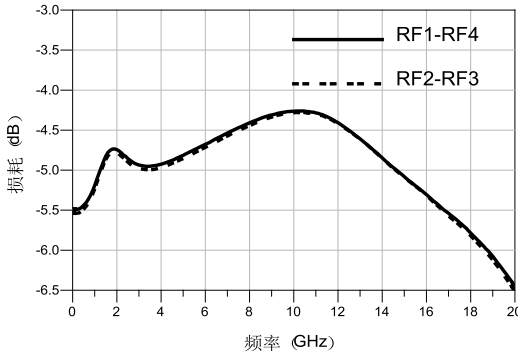
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2~18			GHz
插入损耗	-	-	6.0	dB
隔离度	45	-	-	dB

使用限制参数：

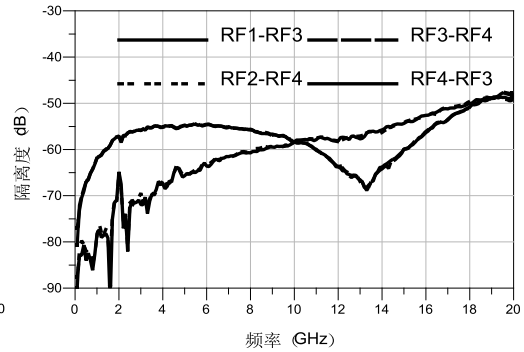
输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

典型曲线：


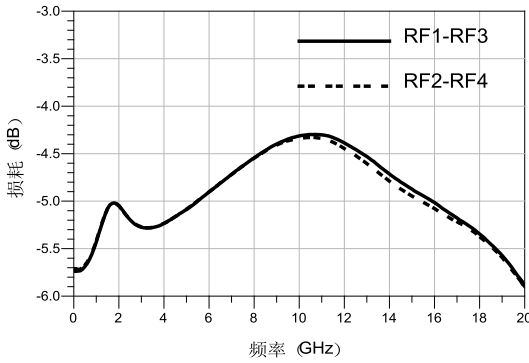
RF1-RF4



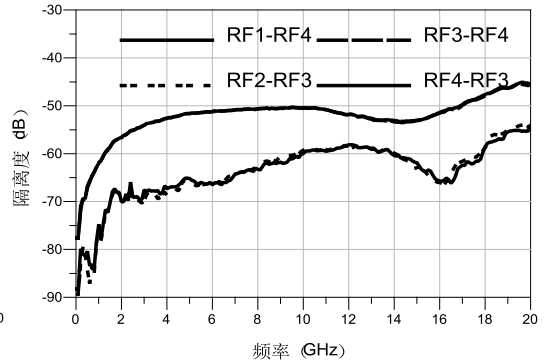
RF2-RF3—ON



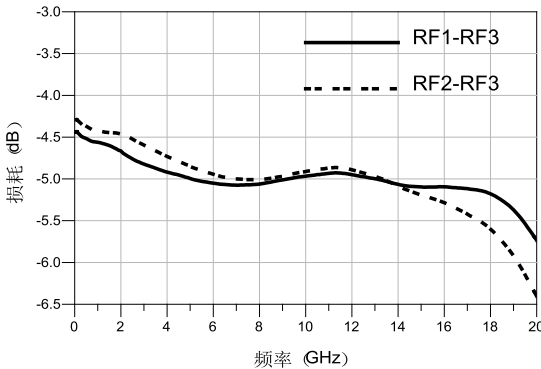
RF1-RF3



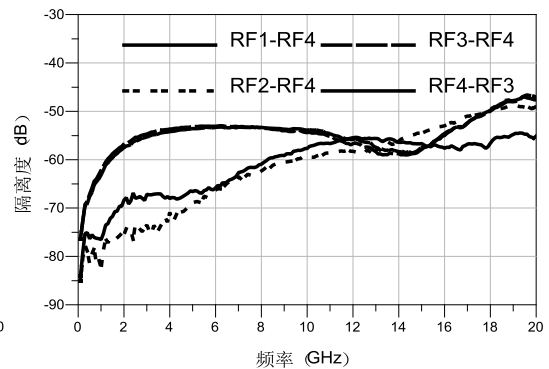
RF2-RF4—ON



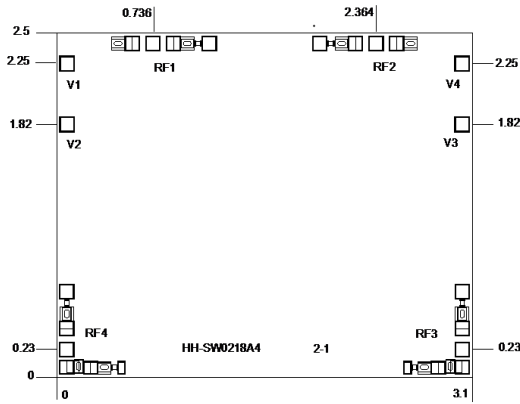
RF1-RF3



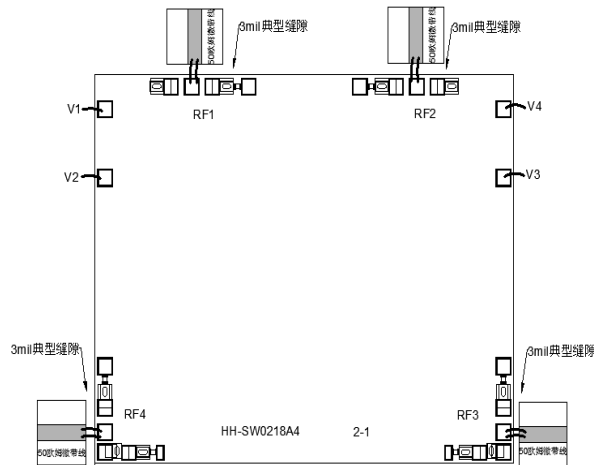
RF2-RF3—ON



尺寸图 : (单位 mm)



建议装配图 :



真值表:

V1	V2	V3	V4	ON	OFF
0	-5	0	-5	RF1→RF4 RF2→RF4	RF1→RF3 RF2→RF3
0	-5	-5	0	RF1→RF4 RF2→RF3	RF1→RF3 RF2→RF4
-5	0	0	-5	RF1→RF3 RF2→RF4	RF1→RF4 RF2→RF3
-5	0	-5	0	RF1→RF3 RF2→RF3	RF1→RF4 RF2→RF4

使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。